

平成 27 年度 第 2 回半導体エレクトロニクス部門委員会 第 1 回研究会 講演プログラム

主 催： 日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会

日 時： 平成 27 年 7 月 11 日(土) 13:00 – 17:40

会 場： 大阪工業大学 うめきたナレッジセンター

(大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC9 階)

プログラム

開会の挨拶 13:00–13:05

委員長 藤原康文

大阪大学 大学院工学研究科

〈基調講演〉 13:05–13:55

半導体メモリデバイス技術と将来への展望

山本和彦

株式会社東芝 半導体研究開発センター

〈一般講演〉

A-1 14:00–14:20

△ **InP 基板上低温成長 $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ の結晶構造**

廣瀬伸悟, 平山賢太郎, 富永依里子, 角屋 豊

広島大学 大学院先端物質科学研究科

A-2 14:20–14:40

△ **大気圧プラズマ CVD 法を用いた $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 薄膜の低温成長**

木口拓也¹, 野瀬幸則¹, 高田賢志¹, 上原 剛², 藤村紀文¹

¹大阪府立大学 大学院工学研究科, ²積水化学工業株式会社

A-3 14:40–15:00

△ **r 面サファイア基板を用いた WO_3 薄膜の分子線エピタキシャル成長**

村山喬之¹, 松尾昌幸¹, 原田義之¹, 小池一步¹, 佐々誠彦¹, 矢野満明¹, 稲葉克彦², 小林信太郎²

¹大阪工業大学 ナノ材料マイクロデバイス研究センター, ²株式会社リガク X 線研究所

A-4 15:00–15:20

光合成菌が合成するテルル結晶ナノ粒子

岡村好子, 松尾忠明, 富永依里子

広島大学 大学院先端物質科学研究科

休息 15:20–15:40

B-1 15:40–16:00

△ **機能性高分子材料の蓄電デバイス電極としての特性**

高見翔馬, 和田直樹, 大澤利幸

大阪工業大学 工学部

B-2 16:00–16:20

△ **紫外線重合したポリシルセスキオキサンをゲート絶縁膜に用いた有機薄膜トランジスタ**

道浦大祐, 中原佳夫, 宇野和行, 田中一郎

和歌山大学 システム工学部

B-3 16:20-16:40

△ **圧電 MEMS 振動発電素子の電気機械変換特性**

荻谷健人¹, 吉村 武¹, 村上修一², 藤村紀文¹

¹大阪府立大学 大学院工学研究科, ²大阪府立産業技術総合研究所

B-4 16:40-17:00

△ **GaAs 中における Er 発光中心の発光制御—フォトリック結晶光ナノ共振器の導入—**

櫻木寛至¹, 児島貴徳¹, 小川雅之¹, 藤岡夏輝¹, 富士田誠之², 小泉 淳¹, 野田 進³, 藤原康文¹

¹大阪大学 大学院工学研究科, ²大阪大学 大学院基礎工学研究科, ³京都大学大学院工学研究科

B-5 17:00-17:20

△ **急速熱アニールによる GaAs 中のエピタキシャル窒素シートにおける 2 次元物性の制御**

小川泰弘, 原田幸弘, 海津利行, 喜多 隆

神戸大学 大学院工学研究科

B-6 17:20-17:40

△ **GaN/Eu 添加 GaN ナノ構造による Eu 発光効率の著しい増大**

朱 婉新¹, Brandon Mitchell², Dolf Timmerman³, 小泉 淳¹, Tom Gregorkiewicz³, 藤原 康文¹

¹大阪大学 大学院工学研究科, ²University of Mount Union, ³University of Amsterdam

△: 「学生優秀講演賞」応募講演